

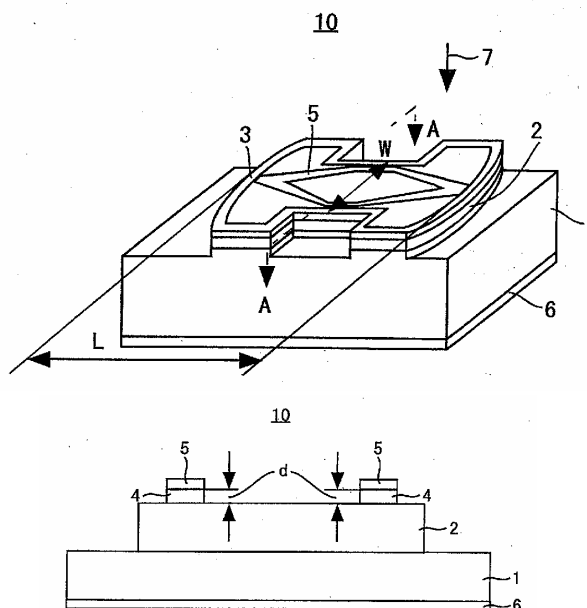
技術の名称

## 半導体レーザー

## 適用分野

## 半導体リングレーザー

- 目的 レーザ発振のためのしきい値電流を低減するとともに、レーザーの発振モード(シングルモード、ツインモード、ロッキングモード)を正確に切り換える。
- 効果 本発明によれば、レーザー発振のためのしきい値電流を低減でき、また発振モードを正確に切り換えることができる。
- 技術概要 半導体基板1上にレーザー光を出射するキャビティ2が設けられており、このキャビティ2に接してリング形状のストライプ層4が形成されるとともに、このリング形状のストライプ層4の表面に接して正極電極5が設けられ、半導体基板1裏面に負極電極6が設けられている。

■ 特記事項,図  
など

- 主たる提供特許 特許等の名称 : 半導体レーザーおよびその製造方法  
登録番号 :  
出願番号 : 特願2006-300133 出願日 : 平成18年11月6日  
公開番号 :

- 実施実績 ○有、無                      ■ 提供形態                      ○実施許諾、×権利譲渡

お問合せ先 株式会社 国際電気通信基礎技術研究所(ATR) 経営統括部 知的財産チーム  
〒619-0288 京都「けいはんな学研都市」光台二丁目2番地2  
TEL 0774-95-2521 E-mail ; patent@atr.jp